

DISPOSIZIONE N. 71 DEL 13/10/2015

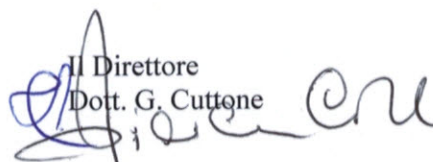
IL DIRETTORE

- Vista la proposta del Dott. Salvatore Tudisco con la quale chiede di acquistare n. 20 wafer di SiC nell'ambito delle Dotazioni di Gr.V dei ns. LNS per un importo presunto di Euro 26.000,00+Iva;
- Ritenuto opportuno accogliere la richiesta;
- Visto che la fornitura richiesta non è presente nel sistema convenzionale CONSIP, né sul MEPA;
- Vista la relazione dello stesso Dott. Tudisco e valutati i motivi dell'acquisto a fornitore unico presso la ETC – 16^ Strada Pantano D'Arce – Blocco Torre Allegra – Zona Industriale - Catania;
- Visto l'art.57 comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006 e s.m. e i.;
- Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INFN, art. 87 comma 1 lett.b) (Del. C.D. 12562 del 26/11/2012);
- Vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 13252 che dà potere ai Direttori dei Laboratori dell'INFN di stipulare contratti sino a € 200.000,00= (Iva esclusa);
- Visto che il bilancio 2015 presenta la necessaria disponibilità

DISPONE

- 1) Di accogliere la richiesta sopra indicata proposta dal Dott. S. Tudisco;
- 2) Di nominare il Dott. G.A.P. Cirrone Responsabile Unico del Procedimento, per svolgere i compiti previsti dall'art. 79 del Regolamento su indicato incluso la richiesta del CIG, così come previsto dalla normativa vigente;
- 3) Di incaricare il RUP a predisporre la lettera di invito per richiedere l'offerta;
- 4) Di ottemperare alla normativa su "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche Amministrazioni";
- 5) Di nominare successivamente una Commissione di esperti che esprimerà parere di congruità sull'offerta pervenuta.

Il Direttore
Dott. G. Cuttone



Catania, 13-10-2015



Al direttore dei LNS
Dr. G. Cuttone

oggetto: procedura d'acquisto per Wafers di Carburo di Silicio (SiC)

Caro Direttore,

nell'ambito delle attività della Call SiCILIA, è stato anticipato al 2015 il finanziamento per l'acquisto di circa 20 wafer di SiC con epitassia da 10 micron drogaggio di tipo n di $5e^{13}/cm^3$ e con ulteriore strato epitassiale superficiale di 0.5 micron di spessore e drogaggio di tipo p di $1e^{19}/cm^3$.

L'ETC - Epitaxial Technology Center sita nella 16a strada, Pantano d'Archi, Blocco Torre Allegra, di Catania è una compagnia che lavora nel settore della tecnologia dei materiali e in particolare nei processi di produzione del SiC ed è in grado produrre dei wafer secondo le nostre specifiche tecniche.

L'ETC garantisce inoltre il controllo della qualità del materiale durante tutto il processo di fabbricazione oltre alla piena disponibilità in fase realizzativa a modifiche dei processi di crescita secondo eventuali specifiche tecniche fornite dal committente.

Grazie inoltre alle nuovissime attrezzature di cui dispone la facility ETC è possibile ridurre a valori bassissimi la concentrazione di droganti dello strato epitassiale. Questa caratteristica rende unica la facility e rappresenta un notevole vantaggio per la produzione di rivelatori perché consente di svuotare tutto lo spessore epitassiale usando tensioni limitate. Altri produttori tipicamente producono epitassie con concentrazioni di droganti che sono un ordine di grandezza superiore a quello di ETC.

Va inoltre osservato che tali wafers non sono presenti su CONSIP e MEPA.

Per tali motivazioni ti chiedo di avviare la procedura d'acquisto considerando ETC unico fornitore. L'importo complessivo stimato per la fornitura è di circa 26 k€.

Dr. S. Tudisco